

УДК 535.343.2; 535 : 548

© 1990

ЧЕРЕНКОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРИ СУБСВЕТОВЫХ СКОРОСТЯХ

Л. А. Коваленко, К. Б. Толпыго

На основе микроскопической теории черенковского излучения [1, 2] рассмотрена генерация светоэкситонов полем электрона, скорость которого меньше скорости света в среде. Рожденные при малых скоростях светоэкситоны по своим характеристикам ближе к так называемым «механическим» или «кулоновским» экситонам [3, 4] и их электромагнитная составляющая представляет собой лишь небольшую часть полной энергии. Однако эти светоэкситоны, рассеиваясь на колебаниях решетки, с определенной вероятностью попадают в область малых волновых векторов $k \ll 1/a$ и, преодолевая за счет теплового движения небольшой барьер (в случае отрицательной эффективной массы «обычного» экситона), переходят на почти прямолинейный участок закона дисперсии $\omega \approx ck/\sqrt{\epsilon_\infty}$, а затем высовываются с частотой в пределах от пуля до некоторого ω_{\max} . Расчеты интенсивности излучения для разных скоростей и ветвей светоэкситонов проведены применительно к параметрам кристаллического Ne .

В макроскопической теории черенковского излучения [5, 6] распределение излучения по частотам выражается через диэлектрическую проницаемость $\epsilon(\omega, k)$, учитывается, в частности, временная и пространственная дисперсия (в области малых $k \ll 1/a$). При этом излучение возникает лишь при сверхсветовых скоростях электрона $v > u = c/\sqrt{\epsilon(\omega, k)}$.

Для получения интенсивности излучения нужно знать зависимость ϵ от частоты и волнового вектора k . Часто используемые разложения ϵ и ϵ^{-1} по степеням k оказываются не всегда возможными именно в окрестности экситонного резонанса, как это, в частности, показал Пекар [7].

В микроскопической теории распространения света в кристалле [1] черенковское излучение выступает как процесс рождения светоэкситонов [3, 4] полем движущегося электрона [2]. При этом должно выполняться условие двойного резонанса по частоте и волновому вектору. Если $\omega(k)$ — закон дисперсии для светоэкситона, а частоты Фурье-разложения поля электрона, движущегося прямолинейно и равномерно со скоростью v , равны kv , то возникает уравнение

$$\omega(k) = kv \cos \theta, \quad (1)$$

где θ — угол между k и v .

На рис. 1 изображены две кривые дисперсии для светоэкситонов, когда эффективная масса «обычного экситона» положительна или отрицательна. Существенно, что в области больших $k \sim 1/a$ светоэкситонные частоты оказываются ограниченными (скажем, частотами возбуждения атомов ω_0) и поэтому равенство (1) за счет больших k может быть выполнено даже при $v \ll c/\sqrt{\epsilon_\infty}$.

Разумеется, рожденный таким образом светоэкситон весьма далек от света в обычном смысле слова. Большая часть его энергии не электромагнитной природы, а представляет просто энергию возбуждения атомной системы. Такой светоэкситон практически не может выйти из кристалла: вследствие выполнения условия Декарта $\sin \alpha / \sin \beta = 1/\sqrt{\epsilon_\infty}$ при $n \gg 1$ он почти всегда испытывает полное внутреннее отражение на границе

Однако вследствие рассеяния на фононах волновой вектор \mathbf{k} может после ряда соударений уменьшиться до величины, сравнимой с волновым вектором света той же частоты в вакууме.

Этот процесс схематически изображен на рис. 1 волнистой линией со стрелкой. Попадая в область почти прямолинейного участка закона дисперсии, где $k \approx \omega/\sqrt{\epsilon_\infty}/c$, такие светоэкситоны уже могут выходить из кристалла в широкой области углов падения α .

Это выглядит как эффект Черенкова с той разницей, что отсутствует соотношение для угла $\cos \theta = 1/\beta n$, где $\beta = v/c$. В [2] это интерпретировалось как рождение экситона быстрыми электронами. Интенсивность излучения будет больше в случае положительных эффективных масс обычного экситона (кривая 1), когда экситон «скатывается», испуская фононы, в область перегиба кривой дисперсии. В случае $m^* < 0$ (кривая 2) рассеяние должно идти с поглощением фононов и вероятность излучения будет уменьшаться пропорционально $\exp(-\Delta E/kT)$, где ΔE — разность энергий между точкой B рождения экситона и точкой A максимума $\omega(k)$.

Ниже будут приведены результаты расчетов зависимости интенсивности излучения от скорости электрона для различных ветвей экситона и направлений \mathbf{v} применительно к параметрам кристаллического неона.

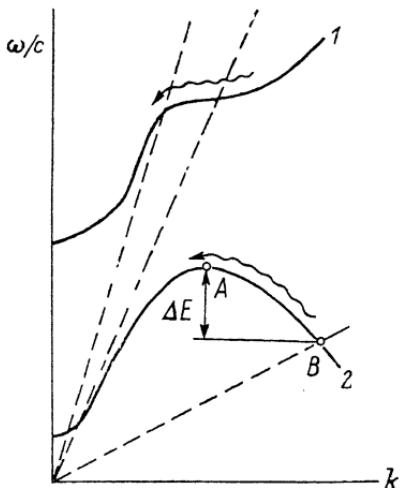


Рис. 1. Дисперсионные кривые светоэкситонов.

Штриховые кривые — закон дисперсии внешнего поля для различных значений v и θ .

1. ЗАКОН ДИСПЕРСИИ СВЕТОЭКСИТОНОВ В ОБЛАСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ \mathbf{k}

Рассматривая распространение света как самосогласованный процесс поляризации каждого атома полем, порожденным всеми прочими атомами [2] приходим к системе уравнений для дипольных моментов всех атомов \mathbf{P}_s^l (l — номер ячейки, s — номер атома в ячейке)

$$\mathbf{P}_s^l = \alpha_s(\omega) \mathbf{E}_s^l, \\ \mathbf{E}_{s\alpha}^l = \frac{1}{a^3} \sum_{s'\beta} \varphi_{ss'}^{\alpha\beta}(\mathbf{k}, \omega) \mathbf{P}_{s'\beta} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_s^l - \omega t)}, \quad (2)$$

где $P_{s\beta}$ — Фурье-компоненты дипольной волны,

$$\mathbf{P}_s^l = P_s e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_s^l - \omega t)}, \quad (3)$$

$\alpha_s(\omega)$ — поляризуемость атома; индексы α, β заменяют координатные значки x, y, z . Тензор $\varphi_{ss'}^{\alpha\beta}(\mathbf{k}, \omega)$ определяется только структурой кристалла. Он был рассчитан в работе [8] для решетки типа NaCl. Для простой гранецентрированной решетки Ne нужно оставить только один индекс $s=s'=1$.

В области $ka \ll 1$, воспользовавшись разложением $\varphi_{ss'}^{\alpha\beta}(\mathbf{k}, \omega)$ [2], из (2) получаем

$$1 - \frac{2\pi}{3} A(\omega) - 2\pi A(\omega) \frac{\omega^2}{c^2 k^2 - \omega^2} = B_{\pm} k^2 a^2, \quad (4)$$

где $B_{\pm} = (3/2\pi)(a_{ss'}^{(1)} + \sigma_{\pm} a_{ss'}^{(3)})$, $a_{ss'}^{(i)}$ — коэффициенты квадратичного разложения величины $\varphi_{ss'}^{\alpha\beta}(\mathbf{k}, \omega)$ (без учета запаздывания),

$$\omega_{\pm} = \frac{1}{2} \left[1 - \sum_{\alpha} s_{\alpha}^4 \pm \sqrt{\left(1 - \sum_{\alpha} s_{\alpha}^4 \right)^2 - 12 s_x^2 s_y^2 s_z^2} \right],$$

$s = k/k$, a — половина ребра куба. Величина $A(\omega) = \omega(\omega)/a^3$ в окрестности дисперсионной частоты ω'_i может быть представлена как

$$A(\omega) \approx \frac{3}{2\pi} \left(1 + a_i \frac{\omega - \omega'_i}{\omega'_i} \right), \quad a_i = \frac{d \ln A(\omega)}{d \ln \omega} \Big|_{\omega'_i}, \quad (5)$$

ω'_i отличается от частоты возбуждения атома на i -й уровень вследствие наличия лорентцева поля.

В области малых $k \sim \omega'_i/c$ и $\omega < \omega'_i$ решение (4) в пренебрежении правой частью есть

$$\omega = \frac{ck}{n}, \quad n^2 = \frac{1 + (4\pi/3) A(\omega)}{1 - (2\pi/3) A(\omega)}. \quad (6)$$

В окрестности дисперсионной частоты ω'_i такое пренебрежение уже незаконно, но можно использовать приближение (5), и тогда

$$\omega_{\pm}(k) \approx \omega'_i \left[1 - \frac{1}{a_i} \left(B_{\pm} k^2 a^2 + 3 \frac{\omega_{\pm}^2(k)}{c^2 k^2} \right) \right]. \quad (7)$$

Соответствующие значения k будем называть «средними»: разложение $\varphi_{ss'}^{\alpha\beta}(k, \omega)$ до квадратичных членов еще возможно, ω близко к ω'_i и слагаемые в круглых скобках (7) сравнимы.

2. Работа внешнего поля над системой дипольных моментов и интенсивность излучения светоэкситонов

Аналогично [2] находим поперечную часть напряженности электрического поля, создаваемого электроном, движущимся со скоростью v

$$E_{ext}^{\perp} = -\frac{ie}{2\pi^2} \int dk \frac{\beta^2 v \cdot s [s(v \cdot s) - v]}{k [1 - \beta^2 (v \cdot s)^2]} \exp[i(k \cdot r - k \cdot vt)], \quad v = v/v. \quad (8)$$

Соотношение между Фурье-компонентами поляризации P_s (3) и напряженностью электрического поля (2) при наличии еще и внешнего поля (8) с частотами $k \cdot v$ будет иметь вид

$$P_{ss} = \frac{1}{a^3} \sum_{\alpha, s' \beta} \varphi_{ss'}^{\alpha\beta} P_{s's} - \frac{ie}{2\pi^2} \frac{i\beta^2 v \cdot s [s_{\alpha} v \cdot s - v_{\alpha}]}{k [1 - \beta^2 (v \cdot s)^2]}. \quad (9)$$

Первые слагаемые правой части — внутреннее поле всех прочих диполей, а второе — внешнее. В результате использования разложения $\varphi_{ss'}^{\alpha\beta}(k, \omega)$ и выражения (5) получим для Фурье-амплитуд P_s формулу

$$P_{ss} = E_{ext, s}^{\perp} \left[\frac{2\pi}{3} \alpha_i \frac{\omega - \omega'_i}{\omega'_i} + \frac{2\pi \omega^2}{c^2 k^2 - \omega^2} + B_{\pm} k^2 a^2 \right]^{-1}, \quad (10)$$

где $E_{ext, s}^{\perp}$ — Фурье-компоненты выражения (8), $\omega = k \cdot v$. Выражение в квадратных скобках (10) обращается в нуль, если $\omega = k \cdot v$ заменить собственной частотой светоэкситона $\omega(k)$, которая определяется в интересующей нас области формулой (7). Вычитаем из выражения в скобках (10) аналогичное ему с заменой $\omega = k \cdot v$ на $\omega(k)$. Собираем все компоненты Фурье и вычитаем из каждого члена решение однородного уравнения (с тем, чтобы полученное решение обращалось в нуль при $t=0$). В результате имеем

$$P_{ss}^I = \frac{a^3}{2\pi} \int dk \frac{A_s E_{\pm} D(k, \omega_{\pm})}{(\omega_{\pm} - k \cdot v) A} \{ \exp[i(k \cdot r_s^I - k \cdot vt)] - \exp[i(k \cdot r_s^I - \omega_{\pm} t)] \},$$

$$D(k, \omega) = \left\{ \frac{1}{3\omega'_i} + \frac{\omega + k \cdot v}{[1 - \beta^2 (v \cdot s)^2] [c^2 k^2 - \omega^2]} \right\}^{-1}, \quad (11)$$

E_{\pm} — составляющие вектора $E_{\text{ext}}^{\perp}(\mathbf{k})$ по направлениям поляризации двух светоэкситонных ветвей, соответствующих корням ω_+ и ω_- .

Зная все \mathbf{P}_{\pm}^l , находим работу внешнего поля над всеми диполями за единицу времени и, как в [2], преобразуем ее к виду

$$W_{\pm} = \frac{e^{2\beta^4}}{2\pi^2} \int d\mathbf{k} \frac{D(\mathbf{k}, \omega_{\pm})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{s})^2 (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_{\pm})^2 \omega_{\pm}}{k^2 [1 - \beta^2 (\mathbf{v} \cdot \mathbf{s})^2]^2} \frac{\sin(\omega_{\pm}t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{v}t)}{\omega_{\pm} - \mathbf{k} \cdot \mathbf{v}}, \quad (12)$$

здесь \mathbf{e}_{\pm} — орты \mathbf{E}_{\pm} . Отношение $[\sin(\omega - \mathbf{k} \cdot \mathbf{v})t]/\pi(\omega - \mathbf{k} \cdot \mathbf{v})$ для всех $t \gg 1/\omega$ приблизительно пропорционально δ -функции, что позволяет в (12) проинтегрировать по k . Полярные углы θ, φ остаются пока свободными аргументами, и подынтегральное выражение (12) представляет собой распределение по углам излучения в резонансе $k=k^0$, где k^0 определяется уравнением, получаемым из (7), (1)

$$\frac{a_i^2}{a_i} B_{\pm} \omega'_i (k_{\pm}^0)^2 + v k_{\pm}^0 \cos \theta - \omega'_i \left(1 - \frac{3}{a_i} \beta^2 \cos^2 \theta\right) = 0. \quad (13)$$

Вследствие сильного рассеяния светоэкситонов в области «средних» k (а следовательно, и k^0) это угловое распределение в эксперименте наблюдаться не будет. Поэтому представляет интерес только интегральное излучение

$$W_{\pm} = -\frac{e^{2\beta^4}}{2\pi} \int d\Omega \frac{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{s})^2 (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_{\pm})^2 \omega_{\pm}(k_{\pm}^0) D(k_{\pm}^0, \omega_{\pm})}{[1 - \beta^2 (\mathbf{v} \cdot \mathbf{s})^2]^2 \left[\frac{d\omega}{dk} \Big|_{k_{\pm}^0} - v \mathbf{v} \cdot \mathbf{s} \right]}. \quad (14)$$

3. Численные результаты для кристаллического неона и их обсуждение

Для вычисления интеграла (14) необходимо знать величины a_i и ω' и задаться определенными направлениями скорости в относительно кристаллографических осей. Они были выбраны как [001], [110], [111]. Предполагалось, что в дисперсионной формуле для $A(\omega)$ доминирует первая резонансная частота ω_1 , равная, по данным [8], 0.682 ат. ед.

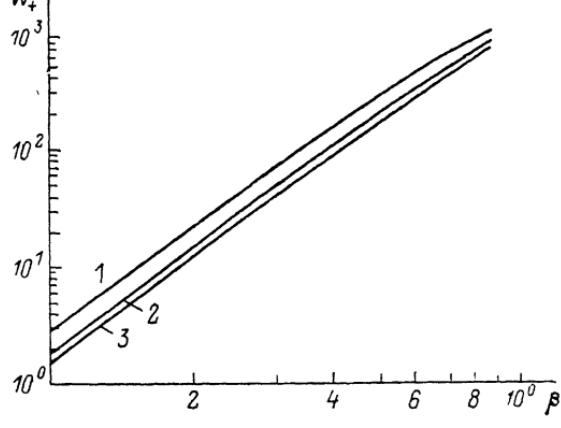


Рис. 2. Зависимость интенсивности излучения от скорости электрона.

При $\omega \rightarrow 0$ $A(0) \approx 3(\epsilon_{\infty} - 1)/2\pi(\epsilon_{\infty} + 2)$, а при $\omega \rightarrow \omega_1$ $A(\omega_1) \approx 3/2\pi$. Отсюда были найдены $a_1 = 26.9$, $\omega'_1 = 0.658$ ат. ед. После этого интегрирование по углам в (14) выполнялось численно и находилась интенсивность излучения для каждого из направлений поляризации.

На рис. 2 изображены кривые $W_+(\beta)$ в двойном логарифмическом масштабе для трех указанных выше направлений скорости. Зависимости $W_-(\beta)$ в случаях 1, 2, 3 близки к кривым 3, 2, 1 для $W_+(\beta)$. Почти прямолинейный ход кривых свидетельствует о приблизительно степенной зависимости $W(\beta) \sim \beta^{2.5}$.

Что же будет наблюдаться на опыте? Его следует ставить при $v < c/\sqrt{\epsilon_\infty}$, когда «обычное» черенковское излучение отсутствует.

Непосредственно рожденные электронами светоэкситоны испытывают многократное рассеяние и подходят к поверхности практически изотропно распределенными. Те из них, которые обладают частотами, близкими к плато на законе дисперсии (рис. 1), и большими показателями преломления, будут преимущественно «расходиться веером» при выходе в вакуум. Те же, которые уже преодолели изгиб в окрестности точки A, могут выходить и под малыми углами. Они практически уже не будут рассеиваться и «спускаться» вниз по кривой $\omega(k)$. Следовательно, спектр излучения будет обрезан сверху, и снизу в небольшой окрестности плато. Каждая ветвь светоэкситонов будет давать излучение соответствующей частоты ω' . При этом более интенсивным и менее температуро-зависящим будет излучение для экситона с положительной эффективной массой.

Теоретический нижний предел для скоростей электронов получится, если подставить в формулу (1) максимальное значение волнового вектора $k \approx 10^8 \text{ см}^{-1}$. При выбранном нами $\omega \approx 0.7$ ат. ед. и $\cos \theta = 1$ это дает $v_{\min} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ см}/\text{с}$, т. е. $\beta \approx 0.01$ (вместо $1/n$). Это почти на 2 порядка меньше скорости, когда наблюдается обычное черенковское излучение, что облегчает постановку эксперимента (электронная энергия $\sim 1 \text{ кэВ}$). К сожалению, из-за резкого убывания интенсивности излучения с уменьшением β (рис. 2) вряд ли удалось бы наблюдать теоретический порог излучения.

Список литературы

- [1] Толпиго К. Б. // УФЖ. 1986. Т. 31. № 2. С. 178—187.
- [2] Толпиго К. Б. // УФЖ. 1987. Т. 32. № 8. С. 1190—1198.
- [3] Пекар С. И. Кристаллооптика и добавочные световые волны. Киев, 1982. 296 с.
- [4] Агранович В. М., Гинзбург В. Л. Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов. М., 1979. 432 с.
- [5] Тамм И. Е., Франк И. М. // ДАН СССР. 1937. Т. 14. С. 107—112.
- [6] Басс Ф. Г., Яковенко В. М. // УФН. 1965. Т. 86. № 2. С. 189—230.
- [7] Пекар С. И. // ФТТ. 1962. Т. 4. № 5. С. 1301—1311.
- [8] Толпиго К. Б., Заславская И. Г. // УФЖ. 1956. Т. 1. № 3. С. 226—244.
- [9] Братцев В. Ф. Таблицы атомных волновых функций / Под ред. М. Г. Веселова. М.; Л., 1966. 192 с.

Донецкий физико-технический институт
АН УССР

Поступило в Редакцию

1 декабря 1989 г.

В окончательной редакции
26 апреля 1990 г.